ESDBL24DP

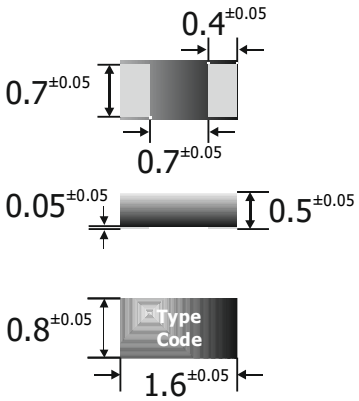
ESD Protection Diodes in SMD
ESD-Schutzdioden in SMD

P_{PPM} = 45 W
T_{jmax} = 150°C

V_{WM} = 24 V
V_{BR} = 24.3 V
$V_{PP\text{-}air}$ = ±20 kV

Version 2018-04-05

0603
(DFN1608)



Dimensions - Maße [mm]

Typical Applications
ESD protection
Data line and I/O port protection
Commercial grade [1])

Typische Anwendungen
ESD-Schutz
Schutz von Datenleitungen und Ein-/Ausgängen
Standardausführung [1])

Features
Bidirectional clamping
Low junction capacitance
Low leakage current
Miniature case outline
Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals [1])

Besonderheiten
Bidirektionales Begrenzen
Niedrige Sperrschicht-Kapazität
Niedriger Sperrstrom
Miniatur-Gehäusebauform
Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien [1])

Halogen FREE

Mechanical Data [1])		**Mechanische Daten [1])**
Taped and reeled	4000 / 7"	Gegurtet auf Rolle
Weight approx.	0.001 g	Gewicht ca.
Case material	UL 94V-0	Gehäusematerial
Solder & assembly conditions	260°C/10s MSL = 1	Löt- und Einbaubedingungen

Tentative
Entwurf

Configuration – Ausführung		Type Code
	Bidirectional – Bidirektional	B4

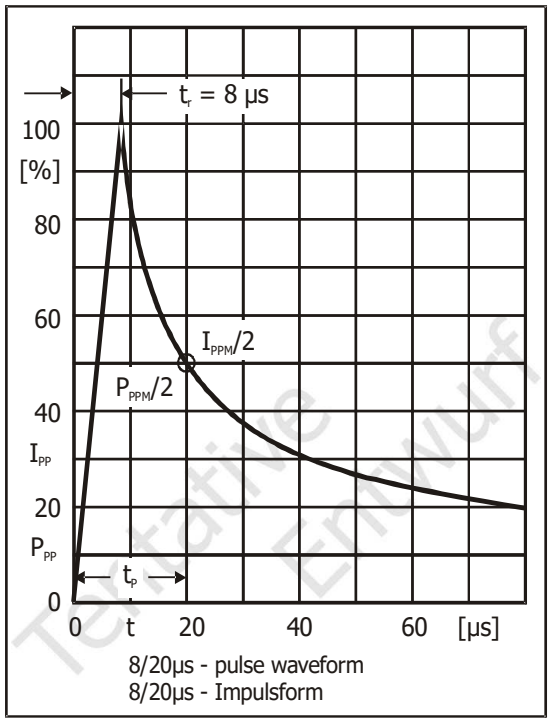
Maximum ratings [2]) **Grenzwerte [2])**

Peak pulse power dissipation (8/20 µs waveform) Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 8/20 µs)	T_A = 25°C	P_{PPM}	45 W [3])
Peak pulse power current (8/20 µs waveform) Impuls-Strom (8/20 µs Impuls)	T_A = 25°C	I_{PPM}	1 A [3])
ESD immunity (air discharge) – ESD-Festigkeit (Luftentladung)	IEC 61000-4-2	V_{PP}	± 20 kV
ESD immunity (contact discharge) – ESD-Festigkeit (Kontaktentladung)	IEC 61000-4-2	V_{PP}	± 18 kV
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_S	-50...+150°C -50...+150°C

1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2 T_A = 25°C unless otherwise specified – T_A = 25°C wenn nicht anders angegeben
3 Non-repetitive pulse see curve I_{PP} = f (t) / P_{PP} = f (t)
Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Impulses, siehe Kurve I_{PP} = f (t) / P_{PP} = f (t)

Characteristics (T_j = 25°C) **Kennwerte (T_j = 25°C)**

Type Typ	Junction capacitance Sperrschichtkapazität V_R = 0 V, f = 1 MHz	Stand-off voltage Sperrspannung	Max. rev. current Max. Sperrstrom at / bei V_{WM}	Breakdown voltage Abbruch-Spannung I_T = 1 mA	
	C_i [pF]	V_{WM} [V]	I_D [µA]	$V_{BR\ min}$ [V]	$V_{BR\ max}$ [V]
ESDBL24DP	3.5	24.0	0.05	24.3	–



Disclaimer: See data book page 2 or website
Haftungssauschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder Internet

1 Mounted on P. C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

© Diotec Semiconductor AG